



汕头华汕电子器件有限公司

A1

NPN SILICON TRANSISTOR

H13003

对应国外型号
3DD13003

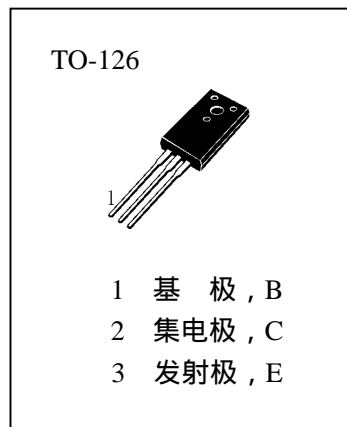
主要用途

高压快速开关

极限值 ($T_a=25$)

T_{stg} ——贮存温度.....	-65~150
T_j ——结温.....	150
P_C ——集电极功率耗散 ($T_c=25$)	40W
V_{CBO} ——集电极—基极电压.....	700V
V_{CEO} ——集电极—发射极电压.....	400V
V_{EBO} ——发射极—基极电压.....	9V
I_C ——集电极电流 (DC)	1.5A
I_B ——基极电流.....	0.75A

外形图及引脚排列



电参数 ($T_a=25$)

参数符号	符号说明	最小值	典型值	最大值	单位	测试条件
BV_{CEO}	集电极—发射极击穿电压	400			V	$I_C=5mA, I_B=0$
I_{EBO}	发射极—基极截止电流			10	μA	$V_{EB}=9V, I_C=0$
$HFE(1)$	直流电流增益	10		40		$V_{CE}=5V, I_C=0.5A$
$HFE(2)$		5				$V_{CE}=2V, I_C=1A$
$V_{CE(sat)}$	集电极—发射极饱和压降			0.5	V	$I_C=0.5A, I_B=0.1A$
				1	V	$I_C=1A, I_B=0.25A$
				3	V	$I_C=1.5A, I_B=0.5A$
$V_{BE(sat)}$	基极—发射极饱和压降			1	V	$I_C=0.5A, I_B=0.1A$
				1.2	V	$I_C=1A, I_B=0.25A$
f_T	特征频率	4			MHz	$V_{CE}=10V, I_C=0.1A$
t_{ON}	导通时间			1.1	μS	} $V_{CC}=125V, I_C=1A$ $I_{B1}=0.2A, I_{B2}=-0.2A$ $R_L=125$
t_{STG}	贮存时间			4.0	μS	
t_F	下降时间			0.7	μS	

分档及其标志

H1	H2	H3	H4	H5
10-16	14-21	19-26	24-31	29-40